SIA



## 性能特点

宽带宽: DC~24GHz
低噪声: 2.7dB典型值
小信号增益: 15dB典型值
輸出P1dR: 15dBm典型值

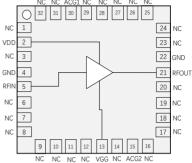
輸出P1dB: 15dBm典型值輸出IP3: 29dBm典型值

● 封装尺寸: 5mm\*5mm 32引脚QFN

## 典型应用

- 点对点通信
- 点对多点通信
- 仪器仪表

# **功能框图**NC



#### 概述

SIA078SP5是一款DC~24GHz低噪声宽带放大器,采用GaAs工艺制造。该放大器具有宽带平坦的增益特点,输入输出端50Ω匹配负载。

## 电性能表(T<sub>A</sub>=+25℃)

参数名称	描述	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率			DG~24		GHz
増益			15		dB
增益平坦度			±0.8		dB
输入回波损耗			15		dB
输出回波损耗			15		dB
输出功率1dB压缩点			15		dBm
饱和输出功率			19		dBm
输出IP3			29		dBm
噪声系数			2. 7		dB
工作电流			70		mA
工作电压			7		٧

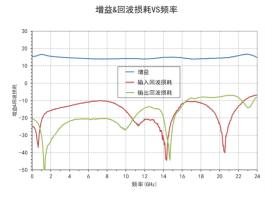
<sup>\*</sup>测试时, 调整栅压VGG从-2V到OV, 以获得工作电流(IDD)典型值70mA。

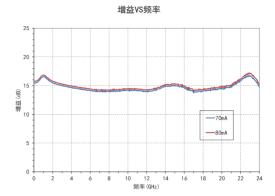
成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

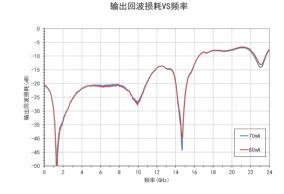
地址:成都市高新西区百川路9号 网址:www.sicoresemi.com

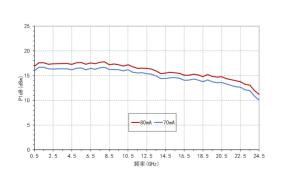


#### 测试曲线

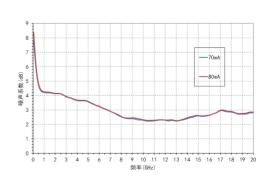








P1dB VS 频率



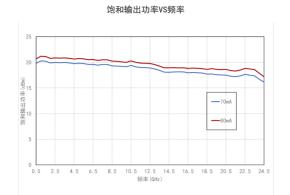
噪声系数VS频率

成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

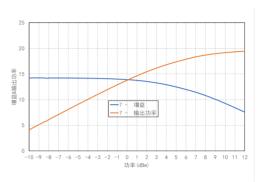
地址:成都市高新西区百川路9号 网址:www.sicoresemi.com



## 测试曲线



#### 增益&输出功率VS频率





## 工作参数

工作温度	-40°C∼+85°C
漏压 V <sub>DD</sub>	7V
电流 I <sub>DD</sub>	55mA

V0.6 2108

## 绝对最大额定值

存储温度	-65°C∼+150°C
漏压 V <sub>DD</sub>	10V
栅压 V <sub>GG</sub>	-2V~+0.2V
ESD-HBM	TBD

## 封装信息

型 <del>号</del>	封装材料	焊盘镀层	MSL等级[1]	封装标识[2]	环保要求
\$1A078\$P5	绿色树脂化合物	NiPdAuAg	MSL 3	S078 XXXXX	符合RoHS

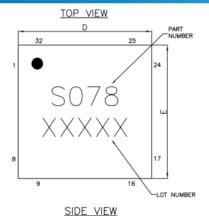
- [1] 最高回流焊温度260°C
- [2] XXXXX为批号

#### 外形尺寸

SIA

放大器系

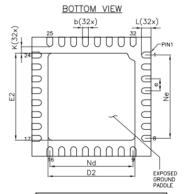
列





#### 说明:

- 1. 单位: mm
- 2. 引线框架材料:铜合金
- 3. 封装表面翘曲: 不大于 0.05mm
- 4. 所有接地引脚请连接PCB射频地



Dimension Table (unit:mm)			
Symbol	MIN	NOM	MAX
Α	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
A2	0.20Ref		
Ь	0.18	0.25	0.30
D	4.90	5.00	5.10
D2	3.50	3.65	3.75
е	0.50BSC		
Ne	3.50BSC		
Nd	3.50BSC		
E	4.90	5.00	5.10
E2	3.50	3.65	3.75
K	0.20		
L	0.30	0.40	0.50
aaa	0.08		

成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号 网址: www.sicoresemi.com

SIA

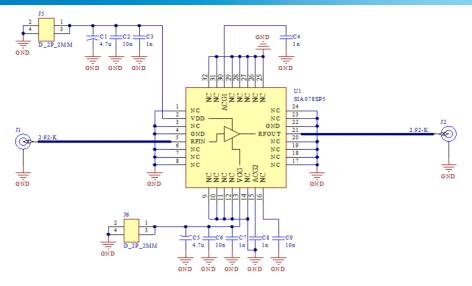


## 引脚定义

引脚编号	功能符号	功能描述	引脚编号	功能符号	功能描述
1	NC	空置	17	NC	空置
2	VDD	漏压	18	NC	空置
3	NC	空置	19	NC	空置
4	GND	射频地	20	NC	空置
5	RFIN	射频输入,直流耦合	21	RFOUT	射频输出, 直流耦合
6	NC	空置	22	GND	射频地
7	NC	空置	23	NC	空置
8	NC	空置	24	NC	空置
9	NC	空置	25	NC	空置
10	NC	空置	26	NC	空置
11	NC	空置	27	NC	空置
12	NC	空置	28	NC	空置
13	VGG	栅压	29	NC	空置
14	NC	空置	30	ACG1	低频接口1
15	ACG2	低频接口2	31	NC	空置
16	NC	空置	32	NC	空置



## 评估板





Designator	Description	
C1, C5	4. 7uF 钽电容 1206	
C2, C6, C9	10nF多层陶瓷电容器 0402	
C3, C4, C7, C8	1nF多层陶瓷电容器 0402	
J1、J2、J3、J4	SMA-K 接头	
	南京傲文 D360B12E01-023	
J5, J6	D_2P_2MM DC引脚	
U1	S1A078SP5	

SPATIS THRU CAL STATE OF THRU

电路板材:Rogers4350B

器件应用的电路板应按照射频电路的设计方法设计,信号 线按50 ohm阻抗设计,同时封装壳体的接地引脚就近接地 (与图中类似),连接顶层与底层接地面应有足够多的接地 孔。

向仕芯半导体申请可获得评估板。

成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号 网址:www.sicoresemi.com